

第 32 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2026

開催概要

電子デバイス産業新聞は最新のエレクトロニクス製品の開発において最も貢献した製品を称えるため「半導体・オブ・ザ・イヤー」を選定しており、本年が第 32 回の開催となります。本年は、①半導体デバイス、②半導体製造装置、③半導体用電子材料の 3 部門でグランプリ 1 点、優秀賞 2 点の最大計 9 点を選定する予定です。

■対象製品

2025 年 4 月～2026 年 3 月までに新製品（バージョンアップなどを含む）として発表された製品・技術

■選考方法

電子デバイス産業新聞の記者によるノミネートを中心とし、記者投票で受賞者を選定します。自薦・他薦も受け付け、記者投票の対象といたします。所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、申し込み締切日 4 月 10 日（金）までにご応募下さい。

受賞者には 4 月下旬までに当社よりご連絡差し上げます。

■発表方法

5 月 21 日（木）または 5 月 28 日（木）発行の電子デバイス産業新聞紙面にて発表予定

■授賞式

2026 年 6 月 10 日（水）午後

電子回路業界で世界最大級の展示会「電子機器トータルソリューション展 2026（JPCA Show 2026 など）」が開催中の東京ビッグサイト会場内

■ご参考

前回開催（第 31 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2025）の受賞者・受賞製品

半導体・オブ・ザ・イヤー 2025 受賞一覧

【半導体デバイス部門】		
グランプリ	インフィニオンテクノロジーズ	世界初の 300mm パワー GaN 技術
優秀賞	日清紡マイクロデバイス、沖電気工業	薄膜アナログ IC の 3 次元集積～アナログ積層回路技術と CFB 技術の融合～
優秀賞	TDK	スピントロニクス技術を用いたニューロモルフィック素子「スピンメモリスタ」
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	沖縄科学技術大学院大学	エネルギー効率を飛躍的に高める革新的な EUV リソグラフィー先端半導体製造技術
優秀賞	LE-TECHNOLOGY	アドバンスドパッケージ用ダイレクト露光装置「LAMBDI」
優秀賞	東レエンジニアリング、東レエンジニアリング先端半導体 MI テクノロジー	パネルレベルパッケージ用の検査、塗布、実装各装置の開発・展開
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	SICC Co., Ltd.	世界初の 300mm SiC ウエハー
優秀賞	三井化学	ハイブリッド接合の低温化に向けた絶縁樹脂の開発
優秀賞	三菱マテリアル	半導体パッケージ向け「角型シリコン基板」

第 32 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2026 応募用紙

(1/2)

■ 応募部門 : 該当するカテゴリー欄にチェックを入れてください。

※2025年4月～2026年3月までに新製品(バージョンアップなどを含む)として発表された製品・技術が対象となります。

半導体デバイス部門 半導体製造装置部門 半導体用電子材料部門

■ 製品名・技術名

--

■ 製品・技術の発表時期

--

■ 追加資料 ある ない

※製品カタログもしくはニュースリリースなどがございましたら、選考に使用させていただきますのでご提供下さい。

(ふりがな) 会社名			
TEL		FAX	
(ふりがな) 申し込み担当者名		所属 役職	
所在地			
会社設立年月日		従業員数	
E-mail		URL	

●複数の製品を応募される場合は、本用紙をコピーのうえご使用下さい。

●E-mailでも応募可能です。応募内容を scnw@sangyo-times.co.jp までお送り下さい。

株式会社産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)		
問合せ	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル 3階	応募期限
送付先	Tel.03-5835-5896 Fax.03-5835-5496 担当:稲葉	4月10日
	E-mail : scnw@sangyo-times.co.jp	

第 32 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2026 応募用紙

(2/2)

■ 応募製品・技術の情報

1) 製品・技術の概要・性能・用途

2) 製品・技術の新規性

3) 製品・技術の納入・導入実績

(株)産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)

問合せ 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル 3階

送付先 Tel.03-5835-5896 Fax.03-5835-5496 担当:稲葉

E-mail : scnw@sangyo-times.co.jp

応募期限

4月10日